

平成二十八年
電子デバイス・半導体電力変換合同研究会

学生奨励賞

中村悠太 殿

論文発表

ゲートドライブ回路モデルを考慮した
SiC-MOSFET過渡特性のシミュレーション検討

平成二十八年 電子デバイス・半導体
電力変換合同研究会における標記の
功績を顕彰するため学生奨励賞を
贈呈致します

平成28年11月15日

一般社団法人 電気学会
シリコンならびに新材料パワーデバイス・パワーIC
技術調査専門委員会 委員長 岩室憲幸
新材料パワー半導体の変換器応用に関する
技術協同研究委員会 委員長 山本真義